

Tentamen i Fasta tillståndets fysik (TIF400/FYP330)

Tid: fm, 2024-04-03

Examinator: Eva Olsson (3247)

Lärare vid tentamen:

Frågorna 1 och 2, Eva Olsson (031 772 3247)

Fråga 3, Mattias Thuvander (073 143 3709)

Frågorna 4 och 5, Elsebeth Schröder (031 772 8424)

Hjälpmedel: Beta, Physics Handbook, penna, sudd, passare, linjal, gradskiva, Chalmersgodkänd räknare i fickformat, utan inprogrammerad text/ekvationer relevant för tentamen, och ett egenproducerat handskrivet A4 (dubbelsidigt) med valfritt innehåll.

Bedömning: Max 100p. Betyg Chalmers: 3- 50p, 4- 70p, 5- 85p. Betyg GU: G- 50p, VG- 75p.

Skriv tydligt och **motivera dina svar.**

Lycka till!

Uppgift 1

Antag att Du har en BCC-struktur med kantlängden $a=3.16 \text{ \AA}$. Basen består av atomerna A i $(0,0,0)$.

- Rita enhetscellen med markerade koordinataxlar x , y och z samt rita in atomerna. Markera (110) -planet och gör en separat skiss av planet med markeringar för atomerna. Beräkna packningstätheten för (110) -planet uttryckt atomer per nm^2 . **(5p)**
- Rita det reciproka gittret. Markera enhetscellen och koordinataxlar x , y och z . Ange kantlängden på enhetscellen uttryckt i a . Rita xz -planet i det reciproka gittret och markera Wigner-Seitz cellen i xz -planet. Ange Miller index för de fyra punkterna närmast origo i xz -planet. **(15p)**

(Observera att uppgifterna kan lösas utan att de tidigare deluppgifterna har lösts.)

Uppgift 2

Antag att Du tar upp ett diffraktogram från ett material som består av en enkel kubisk, SC, struktur med en basen som har atomerna Cs i $(0,0,0)$ och Cl i $(1/2,1/2,1/2)$. Kantlängden på enhetscellen är 4.119 \AA .

- Ta fram uttrycket för strukturfaktorn, S_{hkl} . Ange villkoren för diffraktion och värden på S_{hkl} för olika hkl . Antag att formfaktorerna är $f_{Cs} = C \cdot 55$ och $f_{Cl} =$

C·17 där C är en konstant. Lista Miller index för de tre kortaste planavstånden där villkoret för diffraktion är uppfyllt. **(10p)**

- b. Du studerar materialet med röntgenstrålning med våglängden 1.54 Å och elektronstrålning med våglängden 2.51 pm. Strålningen faller in längs [02-1] i båda fallen. Konstruera Ewald sfären för båda fallen och rita cirklarna där Ewald sfären skär yz-planet. Vilket villkor skall vara uppfyllt för diffraktion? För vilka (hkl) i yz-planet erhålls diffraktion för de två strålningarna? **(10p)**

(Observera att uppgifterna kan lösas utan att de tidigare deluppgifterna har lösts.)

Uppgift 3

- a) Rita ett rektangulärt 2D-gitter med sidorna 3 Å (x-riktning) och 4 Å (y-riktning). **(2p)**
- b) Rita det reciproka gittret. **(5p)**
- c) Markera första och andra Brillouin-zon. Rita noggrant så att de geometriska formerna tydligt syns. **(5 p)**
- d) Rita vågvektorn $k=[3,4 ; 1,2] \text{ \AA}^{-1}$ och bestäm vektorn i första Brillouin-zon som har samma fysikaliska mening gällande gittersvängningar. Rita denna vågvektor, och ange den med siffror. **(8 p)**

Uppgift 4

Vi ska här fokusera på intrinsiska (odopade) halvledare.

- a) Visa att om valens- och ledningsband har samma effektivmassa, $m_e^* = m_h^*$, då är kemiska potentialen mitt i bandgapet, $\mu = E_g/2$. **(5p)**
- b) Visa att om R är resistansen i en cylinder med tvärsnittsarea A och längd L, då är sambandet mellan resistans och konduktivitet σ givet vid $R = L/(A\sigma)$. **(5p)**
- c) För ett prov med odopad germanium mäts följande resistanser vid olika temperaturer T:

T(K)	310	321	339	360	383	405	434
R(Ω)	13.5	9.10	4.95	2.41	1.22	0.74	0.37

Antag att mobiliteten för elektron och hål (μ_e och μ_h) ej beror på temperaturen, och att vi kan försumma temperaturberoendet för elektrontätheten *bortsett* från den dominerande (exponentiella) faktorn.

Beskriv hur energigapet kan bestämmas ur en simpel (linjär) graf, rita grafen hörande till ovanstående mätvärden, och bestäm E_g . **(10p)**

Uppgift 5

I en halvledare beskrivs ledningsbandet (i 3D) kring botten i $\mathbf{k} = 0$ som

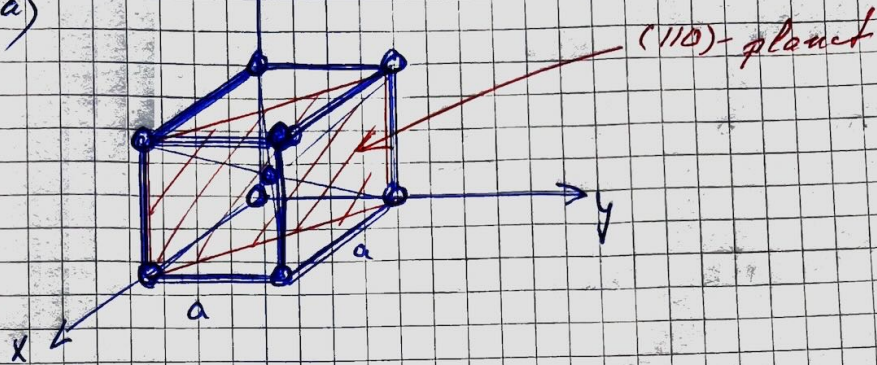
$$E(\mathbf{k}) = A \{1 - \exp(-a k_x^2 - b k_y^2 - b k_z^2)\}$$

där A , a och b , med $a \neq b$, är positiva konstanter i SI enheter och $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$.

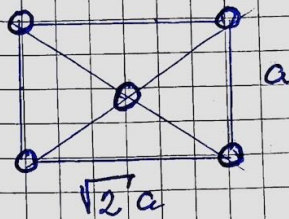
- a) Skissa ledningsbandet (utan värden men med positiva konstanter) kring $\mathbf{k} = 0$ i en av dimensionerna. **(5p)**
- b) Bestäm den inverse effektiva massan i $\mathbf{k} = 0$. **(15p)**

Üppig! $z \uparrow$

a)



(110)-planet



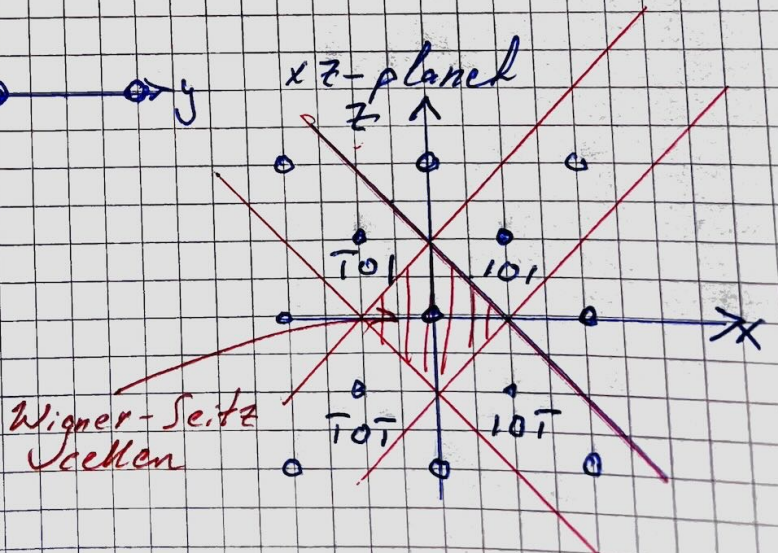
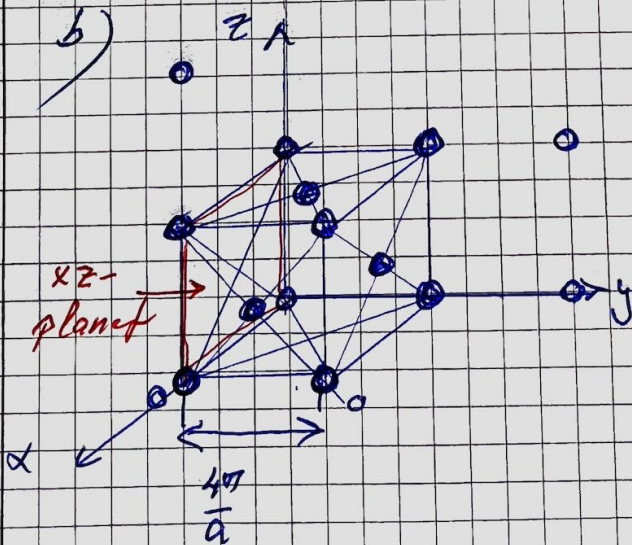
Area: $\sqrt{2} a^2$

Anzahl Atome: 2

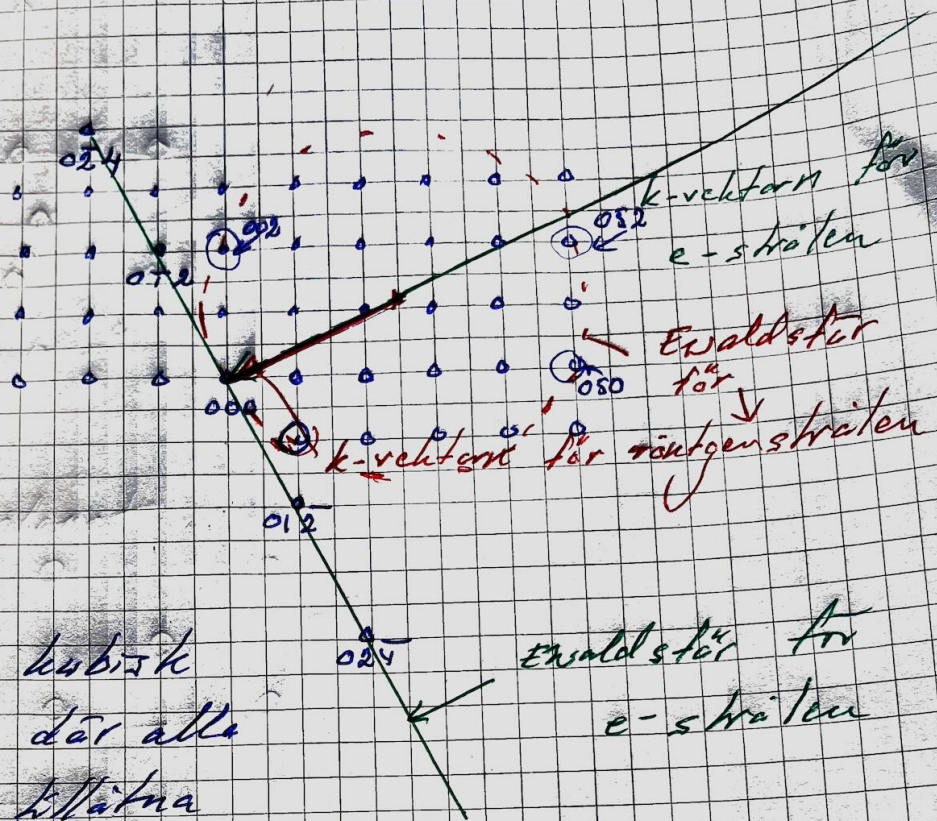
Packungsdichte: $\frac{2}{\sqrt{2} a^2} = \frac{\sqrt{2}}{0.316^2} \text{ Atome/nm}^2$

$= 14.2 \text{ Atome/nm}^2$

b)



Uppg. 12 b



Enkel kubisk
struktur där alla
hål är tillättna

Ewaldstjär för
e-strålen

$|k_c - 1| \Rightarrow |G_{021}| \Rightarrow$ Ewaldstjärren
är i princip ett plan. Diffractionen
erhålls för $(01\bar{2})$, $(0\bar{1}2)$, $(02\bar{4})$, $(0\bar{2}4)$...
planen

$$\frac{|k_{röntgen}|}{|G_{010}|} = \frac{\frac{2\pi}{1.54}}{\frac{2\pi}{4.119}} = \frac{4.119}{1.54} = 2.675$$

För röntgen erhålls diffraction enligt
skets för (002) , (052) och (050) planerna

Uppgift 2a

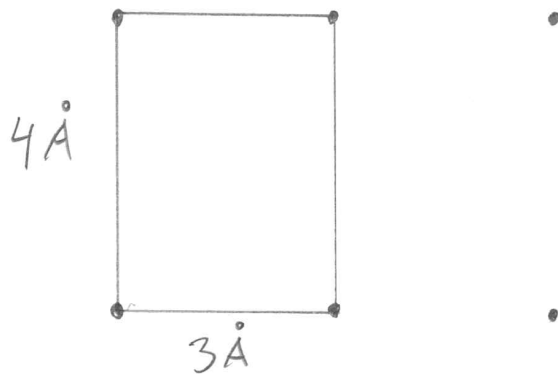
Enkel kubisk struktur med basen Cs i (0, 0, 0) och Cl atom i (1/2,1/2,1/2)

detta ger

$$S_{hkl} = \sum_{j=1}^2 f_j e^{-i\pi \mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} = f_{Cs} + f_{Cl} e^{-i\pi 1/2(h+k+l)}$$

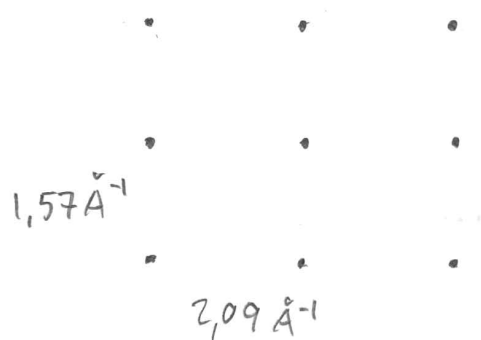
som är $f_{Cs} + f_{Cl} = C(55+17) = 72C$ om $h+k+l$ är ett jämnt tal
 $f_{Cs} - f_{Cl} = C(55-17) = 38C$ om $h+k+l$ är ett udda tal

③ a)

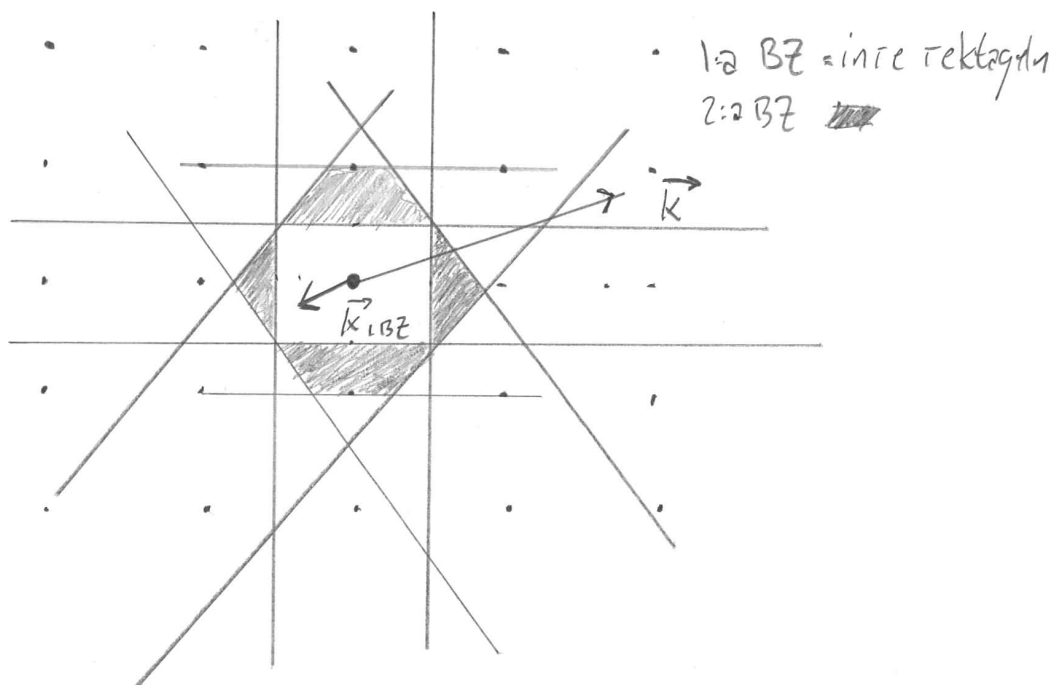


$$b) \vec{a}_1 = 3 \hat{x} \text{ (\AA)} \rightarrow \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{3} \hat{x} = 2,09 \hat{x} \text{ (\AA}^{-1}\text{)}$$

$$\vec{a}_2 = 4 \hat{y} \text{ (\AA)} \rightarrow \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{4} \hat{y} = 1,57 \hat{y} \text{ (\AA}^{-1}\text{)}$$



c)



$$d) \vec{k} = 3,4 \hat{x} + 1,2 \hat{y} \text{ \AA}^{-1}$$

$$\vec{k}_{IBZ} = (3,4 - 2 \cdot 2,09) \hat{x} + (1,2 - 1,57) \hat{y} = -0,78 \hat{x} - 0,37 \hat{y} \text{ (\AA}^{-1}\text{)}$$

$$\vec{k}_{IBZ} = \vec{k} - 2\vec{b}_1 - \vec{b}_2$$

Uppgift 4 Odopad halvledare

a) Om $m_e^* = m_h^*$ är $\mu = E_g/2$:

För odopade halvledare är

$$\mu = E_V + \frac{1}{2} E_g + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_h^*}{m_e^*} \right)$$

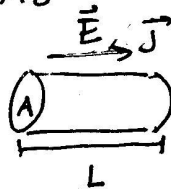
här: $\ln \frac{m_h^*}{m_e^*} = \ln 1 = 0$ dvs $\mu = E_V + \frac{1}{2} E_g$,

antag att valensbandets topp (som vanligt) är nollpunkt för energin,

då är

$$\underline{\mu = \frac{1}{2} E_g.}$$

b) Visa $R = L/A\sigma$



För uniformt fält över längden. L är potentialen $V = E \cdot L$

strömstätheten j ges av $j = \frac{I}{A}$ där I är strömmen genom cylindern.

Konduktiviteten är definierat vid $j = \sigma E$

Ohm's lag säger $V = RI$.

$$\text{Ur detta fås } R = \frac{V}{I} = \frac{EL}{jA} = \underline{\underline{\frac{L}{\sigma A}}}$$

c) För odopad halvledare gäller att

$$\bullet \quad n = p = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-E_g/2k_B T}$$

Vi har också för konduktiviteten att

$\bullet \quad \sigma = en\mu_e + ep\mu_h$ generellt, där $\mu_{e,h}$ är mobiliteten för elektron och hål. Med givna förutsättningar har vi

$\bullet \quad \sigma = en(\mu_e + \mu_h)$ där endast n beror på T

och

$$R = \frac{L}{A} \sigma^{-1} = \frac{L}{Ae(\mu_e + \mu_h)} \frac{1}{n}$$

Ta naturliga logaritmen på båda sidor

$$\ln R = \ln \left(\frac{L}{A e^{(\mu_e + \mu_h)}} \right) - \ln(n)$$

I $n(T)$ antar vi (enligt uppgiften) att T-beroendet i $(\dots)^{3/2}$ -faktorn i n kan försummas. Skriv därför

$$\ln(n) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} \right) - \frac{E_g}{2} \frac{1}{k_B T}$$

\uparrow ignorera T-beroendet \uparrow enda T-beroendet

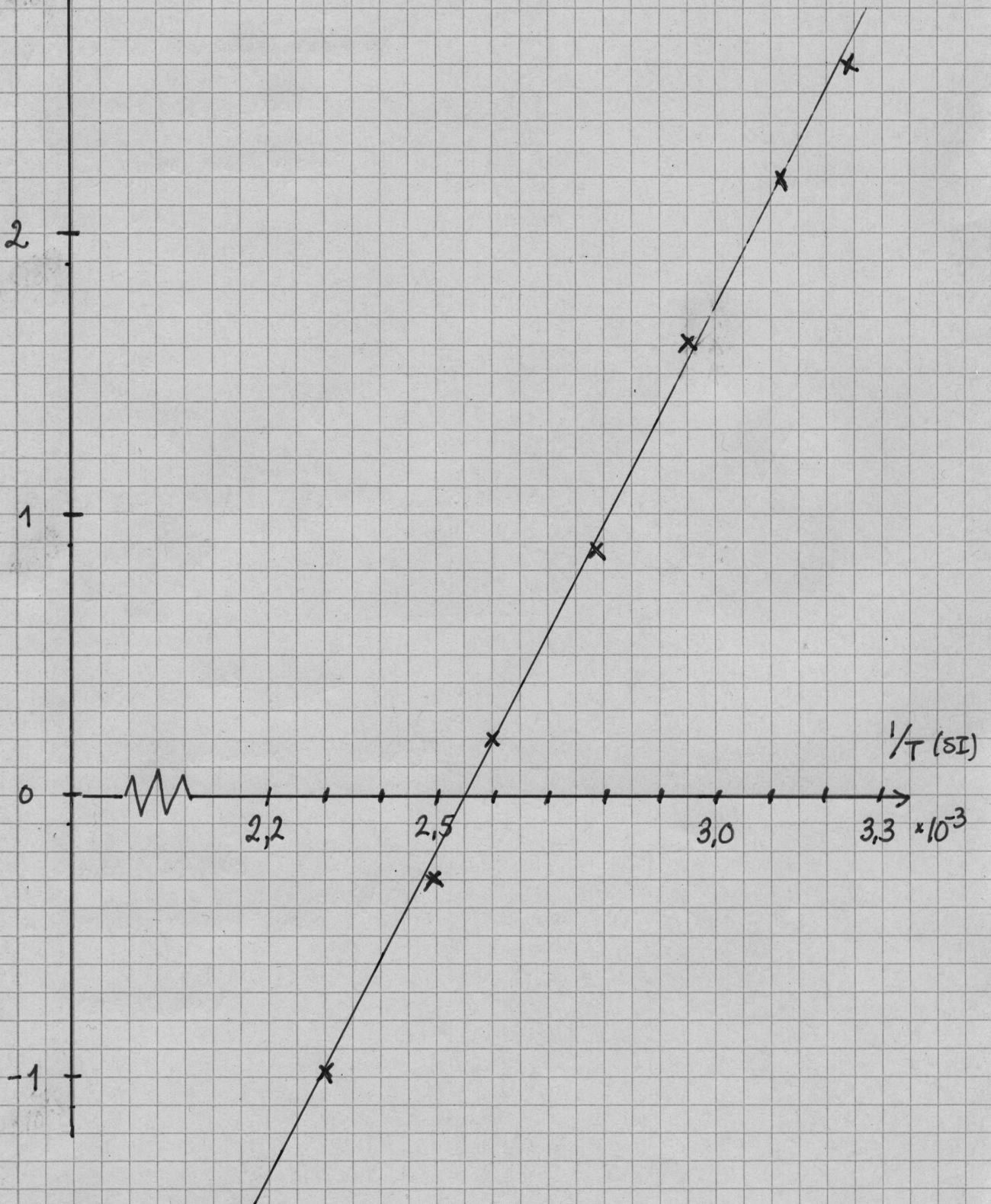
dvs

$$\ln R = \text{konstant} + \frac{E_g}{2} \frac{1}{k_B T}$$

Genom att plotta $\ln R$ mot $\frac{1}{T}$ fås en rät linje och lutningen $E_g / (2k_B)$ ger värdet på E_g .

Värden:	T	1/T	R	ln R
i SI	310	$3.23 \cdot 10^{-3}$	13.5	2.60
	321	3.12	9.10	2.21
	339	2.95	4.95	1.60
	360	2.78	2.41	0.88
	383	2.61	1.22	0.20
	405	2.47	0.74	-0.30
	434	2.30	0.37	-0.99

$\ln R$
(SI) 3



Lutning $\frac{2,7 - (-1)}{(3,25 - 2,3) \cdot 10^{-3}} = 3,9 \cdot 10^3$ (SI)

Ur grafen får vi

$$\frac{E_g}{2k_B} = 3,9 \cdot 10^3 \text{ (SI)}$$

dvs

$$E_g = 2 \cdot k_B \cdot 3,9 \cdot 10^3 \text{ (SI)}$$

$$= 2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 3,9 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$= \underline{1,07 \cdot 10^{-19} \text{ J}}$$

$$= \underline{0,67 \text{ eV}}$$

Uppgift 5. Halvledares ledningsband i 3D

$$E(\vec{k}) = A \left(1 - e^{-ak_x^2 - bk_y^2 - bk_z^2} \right)$$

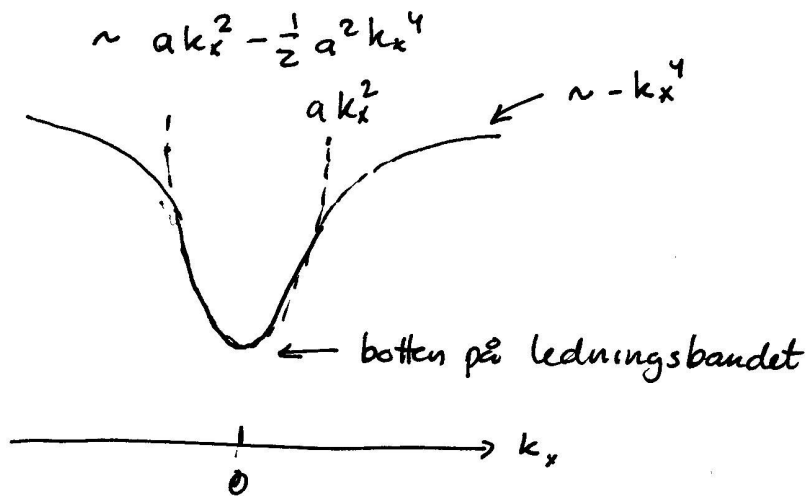
$A, a \neq b$ konstanter > 0 .

a) Skiss ledningsband:

$$E(k)/A \sim 1 - e^{-ak_x^2}$$

Taylorexpansion

$$\leftarrow e^{-ak_x^2} \approx 1 - ak_x^2 + \frac{1}{2} a^2 k_x^4 + \dots$$



b) (Inverse) effektiva massan i $\vec{k} = 0$:

$$\left(\frac{1}{m^*} \right) = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}}^2 E(\vec{k})$$

Derivater:

$$\frac{\partial}{\partial k_x} E(\vec{k}) = -A e^{-ak_x^2 - bk_y^2 - bk_z^2} (-2ak_x)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial k_x^2} E(\vec{k}) &= -A e^{\dots} (-2ak_x)^2 - A e^{\dots} (-2a) \\ &= -A e^{\dots} \left((-2ak_x)^2 - 2a \right) \end{aligned}$$

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial k_x^2} E(\vec{k}) \right|_{\vec{k}=0} = A \cdot 1 (0 + 2a) = 2aA$$

$$\frac{\partial^2}{\partial k_x \partial k_y} E(\vec{k}) = -A e^{\dots} (-2ak_x)(-2bk_y) - A e^{\dots} \cdot 0$$

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial k_x \partial k_y} E(\vec{k}) \right|_{\vec{k}=0} = 0$$

pss för övriga

dvs

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{m_e^*} \right) &= \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} 2aA & 0 & 0 \\ 0 & 2bA & 0 \\ 0 & 0 & 2bA \end{pmatrix} \\ &= \frac{2A}{\hbar^2} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Anisotropisk!